

01;10

Плоская двухщелевая магнитная линза

© В.А. Жуков¹, Е.Н. Котликов¹, В.Д. Гелевер²¹ Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 190000 Санкт-Петербург, Россия² Институт аналитического приборостроения РАН, 198103 Санкт-Петербург, Россия

Поступило в Редакцию 2 июля 1998 г.

Разработана аналитическая модель и получены формулы, описывающие поле плоской магнитной линзы с двумя концентрическими немагнитными зазорами. Продемонстрирована возможность управления величиной "полуширины" магнитного поля линзы с помощью независимого изменения токов в обмотках возбуждения, соответствующих разным немагнитным зазорам, что позволит управлять фокусным расстоянием и величиной сферической aberrации линзы. Показано, что при использовании в обмотках возбуждения токов противоположного направления можно получить плоскую магнитную линзу, не вращающую изображение.

Введение

В последние годы в обычной и растровой электронной микроскопии в качестве электронных объективов все чаще используются плоские магнитные линзы с одним кольцевым немагнитным зазором [1–3]. В силу особенностей своей геометрии эти линзы легко позволяют располагать объект исследования в области максимального магнитного поля. Такое расположение объекта снижает сферическую aberrацию и дает возможность помещать детектор вторичных электронов вне немагнитного зазора линзы. Для ускорения и упрощения анализа электронно-оптических характеристик таких линз нами ранее [3] была предложена простая аналитическая модель магнитного поля плоской магнитной линзы, учитывающая основные особенности ее геометрии, и проведена экспериментальная проверка этой модели. Индукция осевого магнитного поля $B_z(0, 0, z)$ в нашей модели описывается формулой

$$B_z(0, 0, z) = \mu_0 NI \left((\rho_1^2 + z^2)^{-1/2} - (\rho_2^2 + z^2)^{-1/2} \right) (\ln(\rho_1/\rho_2))^{-1}, \quad (1),$$

где $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Н/т}$ — магнитная постоянная вакуума в системе СИ, ρ_1 и ρ_2 — внутренний и внешний радиусы кольцевого немагнитного зазора соответственно, Z — координата вдоль оси электронно-оптической системы, NI — число ампер-витков в катушке возбуждения. "Полуширина" a осевого распределения магнитной индукции $B_z(0, 0, z)$ в поле линзы, описываемом формулой (1), оказалась жестко связанной с внешним ρ_2 и внутренним ρ_1 радиусами немагнитного зазора плоской линзы формулой

$$a = \sqrt{2} \rho_1 \rho_2 (\rho_1^2 + \rho_1 \rho_2 + \rho_2^2)^{-1/2}. \quad (2).$$

Однако для некоторых приложений, связанных, например, с исследованием сверхбольших интегральных схем, было бы полезно иметь магнитный объектив с плавно изменяемым в зависимости от вида исследуемого

объекта значением полуширины распределения индукции осевого магнитного поля $B_z(0, 0, z)$. Это можно осуществить с помощью плоской магнитной линзы не с одним, а с двумя кольцевыми немагнитными зазорами. Каждому немагнитному зазору у такой линзы будет соответствовать своя обмотка возбуждения с независимо изменяемым в ней значением тока.

В настоящей работе мы ставим целью получить обобщение разработанной нами ранее [3] аналитической модели плоской магнитной линзы на случай линзы с двумя немагнитными зазорами (см. рисунок).

Постановка задачи

Как и в работе [3], будем считать, что магнитный скалярный потенциал в принятой модели магнитной линзы задан на плоскости, в которой находятся плоские края центрального и двух внешних, концентрических с ним, полюсных наконечников. Будем по-прежнему считать, следуя Глазеру [4], что магнитное поле внутри узких немагнитных зазоров ортогонально внутренним поверхностям зазоров. Соответствующий такому полю магнитный скалярный потенциал $\Phi_k(\rho)$ внутри немагнитных зазоров будет подчиняться логарифмическому закону

$$\Phi_k(\rho) = A_k \ln(\rho) + B_k, \quad (3)$$

где $\rho = (x^2 + y^2)^{1/2}$ — расстояние от оси линзы до рассматриваемой точки; $K = 1, 2$ — номер немагнитного зазора; A_k и B_k — некоторые константы, определяемые, согласно Глазеру [4], из граничных условий на соседних полюсных наконечниках.

Потенциал же в пределах плоских граней магнитных полюсов будем считать равным константам, отличающимся для соседних полюсов на величину $\mu_0(NI)_k$, где $(NI)_k$ — число ампер-витков в обмотке возбуждения, соответствующей данному немагнитному зазору с номером K , где $k = 1, 2$. В итоге магнитный скалярный потенциал

на всей граничной плоскости оказывается равным

$$\Phi(\rho) = \sum_{k=1}^2 C_k \left(\Theta(\rho) - \Theta(\rho - \rho_{2k-1}) \right) + \frac{\ln(\rho/\rho_{2k})}{\ln(\rho_{2k-1}/\rho_{2k})} \left(\Theta(\rho - \rho_{2k-1}) - \Theta(\rho - \rho_{2k}) \right), \quad (4)$$

где $C_k = \mu_0(NI)_k$; $\Theta(\rho)$ — тэта-функция Хэвисайда, определяемая из условия

$$Q(\rho - \rho_i) = \begin{cases} 0 & \rho < \rho_i, \\ 1 & \rho \geq \rho_i. \end{cases} \quad (5)$$

Таким образом, мы имеем задачу Дирихле уравнения Лапласа для полупространства $z \geq 0$ с граничным условием на плоскости $z = 0$, имеющим вид (4).

Метод решения

Используя функцию Грина задачи Дирихле для полупространства [5], получим следующее выражение для осевого распределения магнитного скалярного потенциала при $Z \geq 0$:

$$\Phi(x, y, z) \Big|_{x=y=0} = \Phi(0, 0, z) = z \int_0^{\infty} \frac{\Phi(\rho) \rho d\rho}{(\rho^2 + z^2)^{3/2}}, \quad (6)$$

где потенциал $\Phi(\rho)$ задан формулой (4).

Используя формулу (6) для скалярного магнитного потенциала на оси системы, получим следующее выражение для осевого распределения индукции магнитного поля:

$$B_z(0, 0, z) = -\frac{\partial \Phi}{\partial z}(0, 0, z) = -\mu_0 \sum_{k=1}^2 D_k \times \left((\rho_{2k-1}^2 + z^2)^{-1/2} - (\rho_{2k}^2 + z^2)^{-1/2} \right)^{-1}. \quad (7)$$

Здесь

$$2_k = (NI)_k \ln(\rho_{2k-1}/\rho_{2k}).$$

Если, как и в работе [3], симметрично продолжить поле вида (7) на область отрицательных значений z , то получится колоколообразное поле, которое, согласно [4], можно аппроксимировать функцией вида

$$B_z(0, 0, z) = B_0 / (1 + (z/a)^2),$$

где $B_0 = B_z(0, 0, 0)$ — максимальное поле на оси z при $z = 0$, а "полуширина" поля в соответствии с [4] определяется формулой

$$a = (-2B_0/B'')^{1/2}, \quad (8)$$

где

$$B'' \equiv \frac{\partial^2}{\partial z^2} B_z(0, 0, z)$$

при $z = 0$. Подставляя в формулу (8) значения B_0 и B'' , вычисленные с помощью поля (7), будем иметь для "полуширины" a выражение

$$a = \left(-2 \sum_{k=1}^2 D_k (\rho_{2k-1}^{-1} - \rho_{2k}^{-1}) / \sum_{k=1}^2 D_k (\rho_{2k-1}^{-3} - \rho_{2k}^{-3}) \right)^{1/2}. \quad (9)$$

Рассмотрим поведение "полуширины" поля a при разных соотношениях между величинами токов в первой и второй обмотках возбуждения. Считаем оба немагнитных зазора узкими, т.е. $\rho_{2k} = \rho_k^* + \Delta$, $\rho_{2k-1} = \rho_k^* - \Delta$ и $\rho_{2k} - \rho_{2k-1} = 2\Delta \ll \rho_k^*$, где ρ_k^* — средний радиус кольцевого зазора с номером k . Поскольку коэффициенты $D_k \sim (NI)_k$, то, полагая в формуле (9) $D_1 \gg D_2$, получим $a_{\min} \approx \rho_1^* \sqrt{2/3}$, а полагая $D_2 \gg D_1$, получим соответственно $a_{\max} \approx \rho_2^* \sqrt{2/3}$.

В случаях когда токи возбуждения в обеих обмотках примерно одинаковы, получаются промежуточные значения параметра "полуширины" a . Таким образом, появляется возможность плавной регулировки величины "полуширины" поля в промежутке $\rho_1^* \sqrt{2/3} \leq a \leq \rho_2^* \sqrt{2/3}$ с помощью изменения относительной величины токов в первой и второй обмотках возбуждения плоской двухщелевой магнитной линзы.

Анализируя формулу (7) для осевого распределения индукции магнитного поля, можно заметить, что при противоположных направлениях токов в катушках возбуждения, соответствующих разным немагнитным зазорам, возможно выполнение условия

$$\int_{z_0}^0 B_z(0, 0, z) dz = 0, \quad (10)$$

что соответствует отсутствию вращения изображения предмета при отображении его с помощью плоской магнитной линзы. При этом предмет находится в плоскости $z = z_0$, а его изображение в плоскости $z = 0$.

Список литературы

- [1] *Magnetic Electron Lenses* / Ed. P.W. Hawkes. West Berlin: Springer, 1982. P. 359–412.
- [2] *Szilgyi M.* Electron and Ion Optics. New York: Plenum Press, 1988. 639 p.
- [3] *Абрамяни А.Б., Гелевер В.Д., Жуков В.А.* // Тез. докл. XIV Всесоюз. конф. по электронной микроскопии. М.: Изд-во АН СССР, 1990. 286 с.
- [4] *Claser W.* Grundlagen Electronenoptik. Wien: Springer Verlag, 1952. 763 s.
- [5] *Смирнов В.М.* Курс высшей математики. Т. II. М.: ГИТТЛ, 1957. 628 с.